



Patent number:

JP2002137398

Publication date:

2002-05-14

Inventor:

HIRAYAMA NOBUYUKI

Applicant:

CANON INC

Classification:

- international:

B41J2/05; B41J2/01

- european:

Application number:

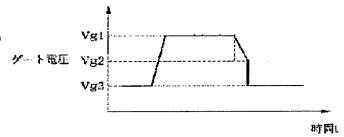
JP20000338075 20001106

Priority number(s):

Abstract of JP2002137398

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce ringing and increase the resistance amount of latch up in a current waveform for driving a heater.

SOLUTION: A voltage waveform with a time constant is applied in an area with a high gate voltage Vg1&rarr Vg2 in the case the NMOS transistor is changed from on to off and a low reference current, and a steep voltage waveform is applied in an area with a low gate voltage Vg2&rarr Vg3 and a reference current increased.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-137398

(P2002-137398A)

(43)公開日 平成14年5月14日(2002.5.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FI.

テーマコート*(参考)

B41J 2/05

2/01

B41J 3/04 103B 2C056

101Z 2C057

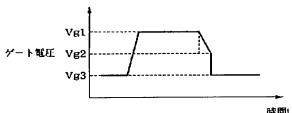
審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 10 頁)

キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 (72)発明者 平山 信之 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内 (74)代理人 100076428 井理士 大塚 康徳 (外2名) 下ターム(参考) 20056 EA01 E007 EC38 FA03 FA10 20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AC83 AM16 AN01 AR17 BA13	(21)出順番号	特顧2000-338075(P2000-338075)	(71)出顧人 000001007
(72)発明者 平山 信之 東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャ ノン株式会社内 (74)代理人 100076428 弁理士 大塚 康徳 (外 2 名) Fターム(参考) 20056 EA01 E007 EC38 FA03 FA10 20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AG83			キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キャ ノン株式会社内 (74)代理人 100076428 弁理士 大塚 康徳 (外 2 名) Fターム(参考) 20058 EA01 E007 EC38 FA03 FA10 20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AG83	(22)出顧日	平成12年11月6日(2000.11.6)	東京都大田区下丸子3丁目30番2号
ノン株式会社内 (74)代理人 100076428 弁理士 大塚 康徳 (外2名) ドターム(参考) 20058 EAD1 ECO7 EC38 FAD3 FA10 20057 AFD1 AF81 AG12 AG46 AG83			(72)発明者 平山 信之
(74)代理人 100076428 弁理士 大塚 康徳 (外2名) Fターム(参考) 20056 EA01 E007 EC38 FA03 FA10 20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AG83			東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
弁理士 大塚 康徳 (外2名) Fターム(参考) 20058 EA01 E007 EC38 FA03 FA10 20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AG83			ノン株式会社内
Fターム(参考) 20058 EA01 E007 EC38 FA03 FA10 20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AG83			(74)代理人 100076428
20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AG83			弁理士 大塚 康徳 (外2名)
			Fターム(参考) 20056 EA01 E007 EC38 FA03 FA10
AM16 ANO1 AR17 BA13		•	20057 AF01 AF81 AG12 AG46 AG83
		•	AM16 ANO1 AR17 BA13

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録ヘッド及びその駆動方法、並びにインクジェット記録装置

(57)【要約】

【課題】ヒータを駆動する電流波形において、リンギン グを少なく、かつラッチアップの耐量を増加させる。 【解決手段】NMOSトランジスタがオンからオフに遷 移するときのゲート電圧がVg1→Vg2と高く、基準電流 が低い領域ではゲートに時定数をもった電圧波形を印加 し、ゲート電圧がVg2→Vg3と低く、基準電流が増加す る領域で、電圧波形を急峻にする。



時間し

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の発熱体と、該複数の発熱体を駆動 するためのスイッチング手段としてMOSトランジスタ を有するインクジェット記録へッドにおいて、

1

前記MOSトランジスタをオンからオフに遷移させるた めの該MOSトランジスタのゲートに印加される電圧波 形が、第1の電圧波形と、該第1の電圧波形に続く第2 の電圧波形から構成され、該第2の電圧波形の単位時間 当たりの電圧変化量が第1の電圧波形の単位時間当たり の電圧変化量に比べて大きく設定したことを特徴とする 10 インクジェット記録へッド。

【請求項2】 前記MOSトランジスタのゲートに、第 1のMOSトランジスタのドレインと、第2のMOSト ランジスタのドレインとが並列に接続され、該第1及び 第2のMOSトランジスタのゲートに印加される電圧波 形が、夫々第3及び第4の波形から構成され、該第3の 波形により第1のMOSトランジスタがオンされ、該第 3の波形に遅れて第4の波形により第2のMOSトラン ジスタがオンされることを特徴とする請求項1に記載の インクジェット記録へッド。

【請求項3】 前記MOSトランジスタのゲートに接続 される容量は、該MOSトランジスタをオンからオフに 遷移させるためのゲートに印加される電圧波形が変化す るにつれて単調に減少することを特徴とする請求項2に 記載のインクジェット記録ヘッド。

【請求項4】 前記記録ヘッドは、インクを吐出して記 録を行うインクジェット記録ヘッドであることを特徴と する請求項1に記載のインクジェット記録ヘッド。

【請求項5】 前記記録ヘッドは、熱エネルギーを利用 える熱エネルギーを発生するための熱エネルギー変換体 を備えていることを特徴とする請求項1に記載のインク ジェット記録ヘッド。

【請求項6】 複数の発熱体と、該複数の発熱体を駆動 するためのスイッチング手段としてMOSトランジスタ を有するインクジェット記録ヘッドの駆動方法であっ て、

第1の電圧波形と、該第1の電圧波形に続く第2の電圧 波形から構成され、該第2の電圧波形の単位時間当たり の電圧変化量が第1の電圧波形の単位時間当たりの電圧 40 変化量に比べて大きく設定した電圧波形を、前記MOS トランジスタをオンからオフに遷移させるための該MO Sトランジスタのゲートに印加することを特徴とするイ ンクジェット記録ヘッドの駆動方法。

【請求項7】 前記MOSトランジスタのゲートに、第 1のMOSトランジスタのドレインと、第2のMOSト ランジスタのドレインとが並列に接続され、該第1及び 第2のMOSトランジスタのゲートに印加される電圧波 形が、夫々第3及び第4の波形から構成され、該第3の 波形により第1のMOSトランジスタがオンされ、該第 50 ンクジェット記録装置。

3の波形に遅れて第4の波形により第2のMOSトラン ジスタがオンされることを特徴とする請求項6に記載の インクジェット記録ヘッドの駆動方法。

【請求項8】 前記MOSトランジスタのゲートに接続 される容量は、該MOSトランジスタをオンからオフに 遷移させるためのゲートに印加される電圧波形が変化す るにつれて単調に減少することを特徴とする請求項6に 記載のインクジェット記録ヘッドの駆動方法。

【請求項9】 前記記録ヘッドは、インクを吐出して記 録を行うインクジェット記録へッドであることを特徴と する請求項6に記載のインクジェット記録ヘッドの駆動 方法。

【請求項10】 前記記録ヘッドは、熱エネルギーを利 用してインクを吐出する記録へッドであって、インクに 与える熱エネルギーを発生するための熱エネルギー変換 体を備えていることを特徴とする請求項6に記載のイン クジェット記録ヘッドの駆動方法。

【請求項11】 複数の発熱体と、該複数の発熱体を駆 動するためのスイッチング手段としてMOSトランジス 20 タを有するインクジェット記録ヘッドを駆動することに より記録を行うインクジェット記録装置において、 第1の電圧波形と、該第1の電圧波形に続く第2の電圧 波形から構成され、該第2の電圧波形の単位時間当たり

の電圧変化量が第1の電圧波形の単位時間当たりの電圧 変化量に比べて大きく設定した電圧波形を、前記MOS トランジスタをオンからオフに遷移させるための該MO Sトランジスタのゲートに印加する制御手段を具備する ことを特徴とするインクジェット記録装置。

【請求項12】 前記MOSトランジスタのゲートに、 してインクを吐出する記録ヘッドであって、インクに与 30 第1のMOSトランジスタのドレインと、第2のMOS トランジスタのドレインとが並列に接続され、該第1及 び第2のMOSトランジスタのゲートに印加される電圧 波形が、夫々第3及び第4の波形から構成され、該第3 の波形により第1のMOSトランジスタがオンされ、該 第3の波形に遅れて第4の波形により第2のMOSトラ ンジスタがオンされることを特徴とする請求項11に記 載のインクジェット記録装置。

> 【請求項13】 前記MOSトランジスタのゲートに接 続される容量は、該MOSトランジスタをオンからオフ に遷移させるためのゲートに印加される電圧波形が変化 するにつれて単調に減少することを特徴とする請求項1 1に記載のインクジェット記録装置。

【請求項14】 前記記録ヘッドは、インクを吐出して 記録を行うインクジェット記録ヘッドであることを特徴 とする請求項11に記載のインクジェット記録装置。

【請求項15】 前記記録ヘッドは、熱エネルギーを利 用してインクを吐出する記録へッドであって、インクに 与える熱エネルギーを発生するための熱エネルギー変換 体を備えていることを特徴とする請求項11に記載のイ

30

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記 録ヘッド及びその駆動方法、並びにインクジェット記録 装置に関する。

3

[0002]

【従来の技術】従来、インクジェットプリンタ等におけ るインクを加熱・発泡させて吐出させるためのヒータの 駆動回路は、特開平11-138775号に開示された 図14のように構成されている。

【0003】図14において、M1~M4はスイッチン グ手段を構成するスイッチ素子としてのNMOSトラン ジスタ、R1~R3は抵抗、VHは電源が供給される端 子、INは制御入力端子である。なお、抵抗R1~R3 はポリシリコンを用いた構成でもよいが、素子基板に作 り込みができる薄膜抵抗であればよい。

【0004】次に、図14の回路動作について簡単に説 明する。

【0005】IN端子にLowレベルからHighレベ ルの信号が入力されるとNMOSトランジスタM1のゲ 20 ートには同様の信号が与えられ、略同じタイミングでオ ン・オフする。しかし、他のNMOSトランジスタM2 ~4 は、それら自身の持つゲート容量と抵抗R 1 ~R 3 によるRC時定数により、ある時間だけ遅れた信号がゲ ートに与えられ、M2, M3, M4の順番にてオン・オ フすることになり、ヒータに流れる電流IHを階段状に することができ、リンギング現像を抑制することができ る。

【0006】これによって、ヒータやスイッチング手段 の劣化や、ノイズによる誤動作を抑制することができ

[0007]

【発明が解決しようとする課題】高速かつ高精細が要求 されるプリンタ等では、記録ヘッドにおけるインクを吐 出するノズルの高密度化及び多ノズル化が図られてい る。ヒータによりインクを加熱・発泡させ、そのエネル ギでインクをノズルから吐出させるインクジェット記録 ヘッドでは、ヒータ駆動をより高速でより多くのヒータ を同時に駆動することが必要とされる。また、ヒータボ ードとしてヒータと駆動回路とを同一基板上に作り込む 40 場合、コストダウンを図るために、ヒータボード面積を 小さくして、同一ボード材から製造できるヒータボード 数を上げることも重要である。

【0008】ここで、上記同時吐出ノズル数の増加やヒ ータボード面積の縮小は、以下のような問題を引き起こ している。

【0009】先ず、同時吐出ノズル数の増加により、電 源からヒータに至る配線本数が増加し、配線領域の面積 が変わらないとすると、ヒータ1つあたりの配線抵抗が

の減少も必要であり、これにより電源からヒータに至る 配線領域も少なくなり、結果として配線抵抗が増大して しまうことがある。

【0010】同様に、チップサイズの縮小は、ヒータを 駆動するトランジスタ領域も少なくなり、トランジスタ のオン抵抗も増大してしまう。

【0011】また、同時吐出ノズル数の増加は、同時に 流れる電流量も増加し、共通配線部分での電圧降下も増 加する。電源電圧とヒータ抵抗値が一定であるとする と、電圧降下によりヒータに流れる電流が減少するた 10 め、ヒータへの投入電力が減る。このため、投入電力の 減少分だけヒータへの電流通電時間(バルス)を増す必 要があるが、高速に吐出させる必要性やパルス幅を短く 急速にインクを急速に加熱することで発泡を安定させる 必要があることから、パルス幅を増加させることが困難

【0012】ヒータへの投入電力の減少分を、パルス幅 を増やすのではなく、ヒータの抵抗値を下げてヒータに 流れる電流を増やした場合、ヒータに直列につながる配 線とトランジスタのオン抵抗とを加算した抵抗値とヒー タ抵抗値との比で決まる全消費電力のうち、ヒータでの 電力の使用効率が減る。

【0013】つまり、高速で印字を行うプリンタにおい て、同時吐出ノズル数が増加してパルス周波数が高くな ることが、さらに消費電力を増大させる要因となってい

【0014】電力の使用効率を上げるには、ヒータに直 列につながる配線抵抗とトランジスタのオン抵抗とを加 算した抵抗 (寄生抵抗) 値とヒータ抵抗値との比を上げ るために、ヒータ抵抗値を増加させ、投入エネルギの減 少分を電源電圧を上げて対応する必要がある。しかしな がら、ヒータを駆動するトランジスタの耐圧以上に電源 電圧を上げることはできないため、電源電圧の最大値は トランジスタの耐圧により決まってしまうという問題が ある。

【0015】次に、図10を参照して、ヒータを駆動す るときの動作について説明する。

【0016】図7における曲線はN型MOSトランジス タ (NMOS) のゲート電圧をパラメータにした時の [d-Vds特性を示す。

【0017】右下がりの直線(負荷線)は、ヒータ抵抗 値と寄生抵抗値とを加算した抵抗値の傾きを持った特性 を電源電圧を基準にとったものである。ヒータに流れる 電流は、NMOSの曲線と負荷曲線の交点上を移動し、 ゲート電圧0Vから所望の電圧まで上げた時の負荷線上 のポイントが各ゲート電圧におけるヒータに流れる電流 である。Vds電圧をさらに上げると、ドレインで急激 に電流が上昇し、ドレイン領域でアバランシュ・ブレー クダウンが生じている。この急激な電流上昇はNMOS 増加する。また、コストダウンの要求からチップサイズ 50 の破壊や劣化といった問題を引き起こす。このため、こ

の領域に負荷線が通過しないような低い電源電圧に設定 される。

【0018】図11は、ゲート電圧をパラメータとした 時の基板電流(Isub)特性を示す。基板電流の増加 する領域は、Id-Vds特性におけるアバランシュ・ ブレークダウンの領域と、ほぼ一致する。 Isub電流 が増加することは、アパランシュ・ブレークダウンが起 こる以外に、Isub電流が発生するNMOS領域とI sub電流を回収する基板コンタクトの間に存在する基 板抵抗に【sub電流が流れ、基板電位を上昇させ、ト ランジスタをオフさせても電流が流れたままになるラッ チアップを引き起こす。

【0019】図10の負荷線に沿った動作を考えた場 合、Isub電流は次の様に流れる。

【0020】負荷線に沿って交点を移動させると、ゲー ト電圧を増加させるとドレイン電流に増加し、次にドレ イン電圧は減少する。各ゲート電圧とVds C対応する Isub電流を求めると、図12及び図13に示す特性 となる。

【0021】ゲート電圧が低い領域でドレイン電圧が高 20 くなるため、Isub電流は増加する。このゲート電圧 の低い領域でのIsub電流の増加は基板電位を上昇さ せ、ラッチアップを引き起こす要因となっている。

【0022】従来、特開平11-138775号に示さ れるように、MOSトランジスタと駆動するヒータ抵抗 以外に存在する寄生の素子の影響により、共振回路が形 成され、スイッチング時に電流波形に誤動作の要因とな るリンギングが生じるため、電流波形の立ち上がり立ち 下がりが急峻にならないような駆動方法が考案されてい る。しかしながら、立ち下がりの波形をなめらかにする 30 に適用可能である。 ためにMOSトランジスタのゲート電圧を時定数をもっ て下げた場合、ゲート電圧の低い状態が持続するため、

lsub電流の通電時間が長くなり、Isub電流に起 因するラッチアップを引き起こし易い、といった問題を 生じていた。

【0023】本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その 目的は、ヒータを駆動するための電圧波形において、リ ンギングが少なく、かつラッチアップの耐量を増加でき るインクジェット記録ヘッド及びその駆動方法、並びに インクジェット記録装置を提供することである。

[0024]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決し、目 的を達成するために、本発明のインクジェット記録へっ ドは、複数の発熱体と、該複数の発熱体を駆動するため のスイッチング手段としてMOSトランジスタを有する インクジェット記録ヘッドにおいて、前記MOSトラン ジスタをオンからオフに遷移させるための該MOSトラ ンジスタのゲートに印加される電圧波形が、第1の電圧 波形と、該第1の電圧波形に続く第2の電圧波形から構 成され、該第2の電圧波形の単位時間当たりの電圧変化 50 のブレードを前後方向に移動可能にする部材であり、本

量が第1の電圧波形の単位時間当たりの電圧変化量に比 べて大きく設定した。

【0025】本発明のインクジェット記録ヘッドの駆動 方法は、複数の発熱体と、該複数の発熱体を駆動するた めのスイッチング手段としてMOSトランジスタを有す るインクジェット記録ヘッドの駆動方法であって、第1 の電圧波形と、該第1の電圧波形に続く第2の電圧波形 から構成され、該第2の電圧波形の単位時間当たりの電 圧変化量が第1の電圧波形の単位時間当たりの電圧変化 量に比べて大きく設定した電圧波形を、前記MOSトラ ンジスタをオンからオフに選移させるための該MOSト ランジスタのゲートに印加する。

【0026】本発明のインクジェット記録装置は、複数 の発熱体と、該複数の発熱体を駆動するためのスイッチ ング手段としてMOSトランジスタを有するインクジェ ット記録へッドを駆動することにより記録を行うインク ジェット記録装置において、第1の電圧波形と、該第1 の電圧波形に続く第2の電圧波形から構成され、該第2 の電圧波形の単位時間当たりの電圧変化量が第1の電圧 波形の単位時間当たりの電圧変化量に比べて大きく設定 した電圧波形を、前記MOSトランジスタをオンからオ フに遷移させるための該MOSトランジスタのゲートに 印加する制御手段を具備する。

[0027]

【発明の実施の形態】以下に、本発明に係る実施の形態 について、添付図面を参照して詳細に説明する。

【0028】尚、以下に説明する実施の形態は、本発明 の実現手段としての一例であり、本発明は、その趣旨を 逸脱しない範囲で下記実施形態を修正又は変形したもの

[装置本体の概略説明] 図1は、本発明の代表的な実施 の形態であるインクジェットプリンタIJRAの構成の 概要を示す外観斜視図である。

【0029】図1において、駆動モータ5013の正逆 回転に連動して駆動力伝達ギア5011、5009を介 して回転するリードスクリュー5005の螺旋溝500 4に対して係合するキャリッジHCはピン(不図示)を 有し、矢印a、b方向に往復移動される。このキャリッ ジHCには、インクジェットカートリッジIJCが搭載 40 されている。5002は紙押え板であり、キャリッジの 移動方向に亙って紙をプラテン5000に対して押圧す る。5007、5008はフォトカプラで、キャリッジ のレバー5006のこの域での存在を確認して、モータ 5013の回転方向切り換え等を行うためのホームポジ ション検知手段である。5016は記録ヘッドの前面を キャップするキャップ部材5022を支持する部材で、 5015はこのキャップ内を吸引する吸引手段で、キャ ップ内開口5023を介して記録ヘッドの吸引回復を行 う。5017はクリーニングブレードで、5019はこ

体支持板5018にこれらが支持されている。プレード は、この形態でなく周知のクリーニングブレードが本例 に適用できることは言うまでもない。又、5012は、 吸引回復の吸引を開始するためのレバーで、キャリッジ と係合するカム5020の移動に伴って移動し、駆動モ ータからの駆動力がクラッチ切り換え等の公知の伝達手 段で移動制御される。

【0030】これらのキャッピング、クリーニング、吸 引回復は、キャリッジがホームポジション側の領域に来 た時にリードスクリュー5005の作用によってそれら 10 形により駆動されるヒータの回路図である。 の対応位置で所望の処理が行えるように構成されている が、周知のタイミングで所望の作動を行うようにすれ ば、本例にはいずれも適用できる。

[制御構成の説明] 次に、上述した装置の記録制御を実 行するための制御構成について説明する。

【0031】図2は、インクジェットプリンタ1JRA の制御回路の構成を示すブロック図である。

【0032】制御回路を示す同図において、1700は 記録信号を入力するインタフェース、1701はMP U、1702はMPU1701が実行する制御プログラ 20 ムを格納するプログラムROM、1703は各種データ (上記記録信号やヘッドに供給される記録データ等)を 保存しておくダイナミック型のRAMである。1704 は記録ヘッド1708に対する記録データの供給制御を 行うゲートアレイであり、インタフェース1700、M PU1701、RAM1703間のデータ転送制御も行 う。1710は記録ヘッド1708を搬送するためのキ ャリアモータ、1709は記録紙搬送のための搬送モー タである。1705はヘッドを駆動するヘッドドライ パ、1706、1707はそれぞれ搬送モータ170 9、キャリアモータ1710を駆動するためのモータド ライバである。

【0033】上記制御構成の動作を説明すると、インタ フェース1700に記録信号が入るとゲートアレイ17 04とMPU1701との間で記録信号がプリント用の 記録データに変換される。そして、モータドライバ17 06、1707が駆動されると共に、ヘッドドライバ1 705に送られた記録データに従って記録ヘッドが駆動 され、印字が行われる。

[記録ヘッドの詳細構成]図3は、本実施形態のインク 40 ジェット記録ヘッドの構成を示す斜視図である。

【0034】図3において、1は通電に応じて発熱しイ ンクに発泡を生じさせてインク吐出を行わせるための電 気熱変換素子を構成するための発熱抵抗体であり、配線 と共に基板21上に半導体と同様の製造工程を経て形成 されている。25は発熱抵抗体1に対応して吐出口22 およびこれに連通した液路23を形成するための液路形 成部材である。24は、各々の液路23に共通した液室 であり、不図示のインク供給源から供給されたインクを 貯留する。26は、天板である。

【0035】次に、図3に示した記録ヘッドを駆動する ための駆動回路の構成及び動作について説明する。ヘッ ド駆動回路は、基板21に半導体と同様の製造工程を経 て形成される。

【0036】尚、以下では、NMOSトランジスタによ りヒータを駆動する場合について説明する。

[第1の実施形態] 図4は、本発明に係る第1実施形態 のスイッチング素子としてのNMOSトランジスタのゲ ート電圧の駆動波形を示す図である。図5は、図4の波

【0037】図4及び図5において、R1は発熱抵抗体 としてのヒータ、MlはNMOSトランジスタ、Vgは 駆動波形の入力端子、VHに電流が接続される。

【0038】本実施形態は、NMOSトランジスタM1 がオンからオフに遷移する時、即ち、図4に示す駆動波 形の立ち下がり部分において、ゲート電圧Vg1でトラ ンジスタM1がオンし、Vg3でトランジスタM1がオ フするものであり、Vg2は図10乃至図13のIsu b-Vgs特性において、ゲート電圧をVg1から徐々 に下げたとき Isub電流が増加し始める直前の電圧で ある。

【0039】また、ゲート電圧Vg1からVg2までの単 位時間当たりの電圧変化量に対し、Vg2からVg3の単 位時間当たりの電圧変化量は大きく設定されている。

【0040】トランジスタM1のゲート電圧がVg1か らVg2まで遷移するとき、ヒータR1に流れる電流は ゲート電圧の減少に伴って、徐々に減少する。この時ヒ ータに流れる電流の減少により、ヒータでの電圧降下分 が徐々に減少するため、トランジスタM1のドレイン電 30 圧が上昇する。ゲート電圧がVg2からVg3に遷移する とき、ヒータに流れる電流はさらに減少するので、トラ ンジスタM1のドレイン電圧はVH付近まで上昇する。 【0041】このドレイン電圧の上昇により、「sub 電流が長く流れ始める。ところが、Isub電流が流れ るゲート電圧であるVg2からVg3に遷移する時間が短 く、電圧変化が急峻にすることで、Isub電流の通電 時間を短くすることができる。

【0042】Isub電流が発生するトランジスタとI s u b電流を回収する基板コンタクト部分との間に介在 する寄生の抵抗と、抵抗に分布する容量に1gub電流 が流れることで、基板電位は時定数をもって上昇する。 Isub電流の通電時間が短くなることで、基板電位の 上昇と時間を抑えることができ、結果としてラッチアッ プを抑制することができる。また、ゲート電圧がVg1 からVg2に遷移する時間を長くとることで、ヒータ電 流の急峻な変化を抑えることができ、電流のリンギング に対する誤動作を抑制することができる。

[第2の実施形態] 図6は、本発明に係る第2実施形態 のスイッチング素子としてのNMOSトランジスタのゲ 50 ート電圧の駆動波形を示す図である。図7は、図6の波 形により駆動されるヒータの回路図である。

【0043】図6のゲート電圧G1、G2は、図7のトランジスタM2、M3のゲートG1、G2に入力される波形を表している。尚、第1の実施形態と同一の構成には、同一の番号を付して説明を省略する。

【0044】図6及び図7において、L1は電源に接続される負荷素子またはスイッチング素子であり、M2、M3はNMOSトランジスタである。トランジスタM2、M3はゲート電圧G1、G2が "High" レベルでオンとなり、 "Low" レベルでオフとなる。トラン 10ジスタM2のゲート電圧が "High" となると、トランジスタM2の出力レベルは "Low" となり、トランジスタM1はオフになる。トランジスタM2のゲート電圧G1が "Low" のとき負荷素子L1を介して、トランジスタM2の出力レベルは "High"となり、トランジスタM1をオンさせる。

【0045】図6において、ゲート電圧G1が"Low"から"High"レベルに遷移するとき、トランジスタM1がオンからオフに遷移する。この時、トランジスタM3のゲート入力端子G2がオンからオフに遷移す 20る。トランジスタM1のゲート電圧は、トランジスタM2のゲートに蓄積された電荷がトランジスタM2を介して放電され、トランジスタM1のゲート端子に寄生する容量とトランジスタM2のオン抵抗で決まる時定数をもって徐々に減少する。この時に、トランジスタM3がオンすることで、トランジスタM1に蓄積された電荷が急速に放電され、図4のようなゲート電圧波形となる。

【0046】即ち、トランジスタM1のオンからオフ時の動作は第1の実施形態の場合と同じになり、ラッチア 30ップを抑制する効果を持っている。

[第3の実施形態]図8は、本発明に係る第2実施形態のヒータの駆動回路図である。図9は、PMOSの基板電位を基準として、ドレイン電圧を変化させたときのドレイン容量の変化の一例を示す図である。

【0047】図8において、M4はPMOSトランジスタであり、M4のドレイン端子はM1のゲート端子に接続される。B1はM1のゲートを駆動するロジック回路である。尚、第1の実施形態と同一の構成には、同一の番号を付して説明を省略する。

【0048】トランジスタM1がオンからオフに遷移する時、ロジック回路B1によりトランジスタM1のゲート電圧は"High"レベルから"Low"レベルに変化する。このときのドレイン電圧と電源電圧VDOとの電圧差は、トランジスタM1のゲート電圧が低くなるに従って増加する。図9から、トランジスタM4の基準電位が電源電圧VDOに接続されている場合、トランジスタM1のゲート電圧が低くなるに従って容量値も減少する。

【0049】即ち、トランジスタM1のゲート電圧が低 50

くなると同時に、ゲートに接続されたトランジスタM4のドレイン端子における容量が小さくなるため、トランジスタM1のゲート電圧の駆動波形は、ゲート電圧が低くなるに従って立ち下がりが急峻となる。これは第1の実施形態と同様にゲート電圧が低いときにゲート電圧の遷移時間が短くなり、Isub電流の通電時間も短くなることにより、ラッチアップが抑制されることになる。【0050】以上説明したように、本実施形態によれば、NMOSトランジスタがオンからオフに遷移するときのゲート電圧が高く、Isub電流が低い領域ではゲートに時定数をもった電圧波形を印加し、ゲート電圧が低く、Isub電流が増加する領域で、電圧波形を急峻にすることにより、ヒータを駆動するための電圧波形において、リンギングが少なく、かつラッチアップの耐量を増加できる。

【0051】なお、以上の実施形態において、記録へっドから吐出される液滴はインクであるとして説明し、さらにインクタンクに収容される液体はインクであるとして説明したが、その収容物はインクに限定されるものではない。例えば、記録画像の定着性や耐水性を高めたり、その画像品質を高めたりするために記録媒体に対して吐出される処理液のようなものがインクタンクに収容されていても良い。

【0052】以上の実施形態は、特にインクジェット記録方式の中でも、インク吐出を行わせるために利用されるエネルギーとして熱エネルギーを発生する手段(例えば電気熱変換体やレーザ光等)を備え、前記熱エネルギーによりインクの状態変化を生起させる方式を用いることにより記録の高密度化、高精細化が達成できる。

【0053】その代表的な構成や原理については、例え ば、米国特許第4723129号明細書、同第4740 796号明細書に開示されている基本的な原理を用いて 行うものが好ましい。との方式はいわゆるオンデマンド 型、コンティニュアス型のいずれにも適用可能である が、特に、オンデマンド型の場合には、液体(インク) が保持されているシートや液路に対応して配置されてい る電気熱変換体に、記録情報に対応していて核沸騰を越 える急速な温度上昇を与える少なくとも1つの駆動信号 を印加することによって、電気熱変換体に熱エネルギー を発生せしめ、記録ヘッドの熱作用面に膜沸騰を生じさ せて、結果的にとの駆動信号に1対1で対応した液体 (インク)内の気泡を形成できるので有効である。この 気泡の成長、収縮により吐出用開口を介して液体(イン ク)を吐出させて、少なくとも1つの滴を形成する。と の駆動信号をパルス形状をすると、即時適切に気泡の成 長収縮が行われるので、特に応答性に優れた液体(イン ク) の吐出が達成でき、より好ましい。

【0054】このパルス形状の駆動信号としては、米国特許第4463359号明細書、同第4345262号明細書に記載されているようなものが適している。な

11

お、上記熱作用面の温度上昇率に関する発明の米国特許 第4313124号明細書に記載されている条件を採用 すると、さらに優れた記録を行うことができる。

【0055】記録ヘッドの構成としては、上述の各明細書に開示されているような吐出口、液路、電気熱変換体の組み合わせ構成(直線状液流路または直角液流路)の他に熱作用面が屈曲する領域に配置されている構成を開示する米国特許第455833号明細書、米国特許第4459600号明細書を用いた構成も本発明に含まれるものである。加えて、複数の電気熱変換体に対して、共通するスロットを電気熱変換体の吐出部とする構成を開示する特開昭59-123670号公報や熱エネルギーの圧力波を吸収する開口を吐出部に対応させる構成を開示する特開昭59-138461号公報に基づいた構成としても良い。

【0056】さらに、記録装置が記録できる最大記録媒体の幅に対応した長さを有するフルラインタイプの記録 ヘッドとしては、上述した明細書に開示されているような複数記録ヘッドの組み合わせによってその長さを満たす構成や、一体的に形成された1個の記録ヘッドとして 20 の構成のいずれでもよい。

【0057】加えて、上記の実施形態で説明した記録へッド自体に一体的にインクタンクが設けられたカートリッジタイプの記録へッドのみならず、装置本体に装着されることで、装置本体との電気的な接続や装置本体からのインクの供給が可能になる交換自在のチップタイプの記録へッドを用いてもよい。

【0058】また、以上説明した記録装置の構成に、記録ヘッドに対する回復手段、予備的な手段等を付加することは記録動作を一層安定にできるので好ましいもので 30ある。これらを具体的に挙げれば、記録ヘッドに対してのキャッピング手段、クリーニング手段、加圧あるいは吸引手段、電気熱変換体あるいはこれとは別の加熱素子あるいはこれらの組み合わせによる予備加熱手段などがある。また、記録とは別の吐出を行う予備吐出モードを備えることも安定した記録を行うために有効である。

【0059】さらに、記録装置の記録モードとしては黒色等の主流色のみの記録モードだけではなく、記録ヘッドを一体的に構成するか複数個の組み合わせによってでも良いが、異なる色の複色カラー、または混色によるフ 40ルカラーの少なくとも1つを備えた装置とすることもできる。

【0060】以上説明した実施の形態においては、インクが液体であることを前提として説明しているが、室温やそれ以下で固化するインクであっても、室温で軟化もしくは液化するものを用いても良く、あるいはインクジェット方式ではインク自体を30°C以上70°C以下の範囲内で温度調整を行ってインクの粘性を安定吐出範囲にあるように温度制御するものが一般的であるから、使用記録信号付与時にインクが液状をなすものであれば50

よい。

【0061】加えて、積極的に熱エネルギーによる昇温 をインクの固形状態から液体状態への状態変化のエネル ギーとして使用せしめることで積極的に防止するため、 またはインクの蒸発を防止するため、放置状態で固化し 加熱によって液化するインクを用いても良い。いずれに しても熱エネルギーの記録信号に応じた付与によってイ ンクが液化し、液状インクが吐出されるものや、記録媒 体に到達する時点では既に固化し始めるもの等のよう 10 な、熱エネルギーの付与によって初めて液化する性質の インクを使用する場合も本発明は適用可能である。この ような場合インクは、特開昭54-56847号公報あ るいは特開昭60-71260号公報に記載されるよう な、多孔質シート凹部または貫通孔に液状または固形物 として保持された状態で、電気熱変換体に対して対向す るような形態としてもよい。本発明においては、上述し た各インクに対して最も有効なものは、上述した膜沸騰 方式を実行するものである。

【0062】さらに加えて、本発明に係る記録装置の形 の 態としては、コンピュータ等の情報処理機器の画像出力 端末として一体または別体に設けられるものの他、リー ダ等と組み合わせた複写装置、さらには送受信機能を有 するファクシミリ装置の形態を取るものであっても良 い。

【他の実施形態】なお、本発明は、複数の機器(例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ、ブリンタなど)から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置(例えば、複写機、ファクシミリ装置など)に適用してもよい。

【0063】また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体(または記録媒体)を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているオペレーティングシステム(OS)などが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0064】さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示

13

に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備 わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、 その処理によって前述した実施形態の機能が実現される 場合も含まれることは言うまでもない。

[0065]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1、6、1 1の発明によれば、第1の電圧波形と、該第1の電圧波 形に続く第2の電圧波形から構成され、該第2の電圧波 形の単位時間当たりの電圧変化量が第1の電圧波形の単 位時間当たりの電圧変化量に比べて大きく設定した電圧 10 波形を、MOSトランジスタをオンからオフに遷移させ るためのMOSトランジスタのゲートに印加することに より、リンギングが少なく、かつラッチアップ耐量を増 加できる。

【0066】請求項2、7、12の発明によれば、MO Sトランジスタのゲートに、第1のMOSトランジスタ のドレインと、第2のMOSトランジスタのドレインと が並列に接続され、第1及び第2のMOSトランジスタ のゲートに印加される電圧波形が、夫々第3及び第4の 波形から構成され、該第3の波形により第1のMOSト 20 ランジスタがオンされ、該第3の波形に遅れて第4の波 形により第2のMOSトランジスタがオンされることに より、ラッチアップを抑制することができる。

【0067】請求項3、8、13の発明によれば、MO Sトランジスタのゲートに接続される容量は、MOSト ランジスタをオンからオフに遷移させるためのゲートに 印加される電圧波形が変化するにつれて単調に減少する ことにより、ラッチアップを抑制することができる。

【0068】請求項4、9、14の発明によれば、記録 ヘッドは、インクを吐出して記録を行うインクジェット 記録ヘッドであることにより、同時吐出ノズル数を増加 でき、記録時間を高速化できる。

【0069】請求項5、10、15の発明によれば、記 録ヘッドは、熱エネルギーを利用してインクを吐出する 記録ヘッドであって、インクに与える熱エネルギーを発*

*生するための熱エネルギー変換体を備えていることによ り、同時吐出ノズル数を増加でき、記録時間を高速化で きる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の代表的な実施の形態であるインクジェ ットプリンタ【JRAの構成の概要を示す外観斜視図で ある。

【図2】インクジェットプリンタ【JRAの制御回路の 構成を示すブロック図である。

【図3】本実施形態のインクジェット記録ヘッドの構成 を示す斜視図である。

【図4】本発明に係る第1実施形態のスイッチング素子 としてのNMOSトランジスタのゲート電圧の駆動波形 を示す図である。

【図5】図4の波形により駆動されるヒータの回路図で

【図6】本発明に係る第2実施形態のスイッチング素子 としてのNMOSトランジスタのゲート電圧の駆動波形 を示す図である。

【図7】図6の波形により駆動されるヒータの回路図で

【図8】本発明に係る第2実施形態のヒータの駆動回路 図である。

【図9】PMOSの基板電位を基準として、ドレイン電 圧を変化させたときのドレイン容量の変化の一例を示す 図である。

【図10】NMOSトランジスタのId-Vds特性で

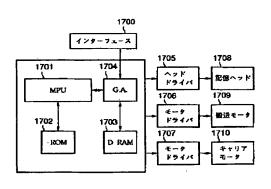
【図11】NMOSトランジスタのIsub-Vgs特 30 性である。

【図12】NMOSトランジスタの『sub-Vgs特

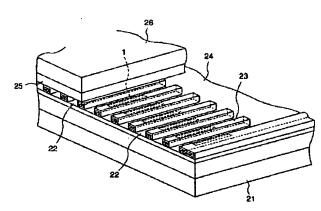
【図13】NMOSトランジスタのIsub-Vgs特 性である。

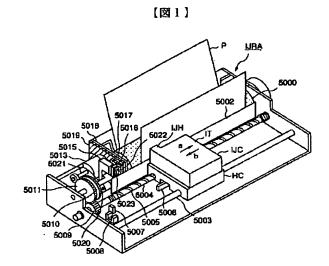
【図14】従来例のヒータの駆動回路を示す図である。

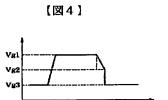
【図2】



[図3]







【図8】

